

ompl. of BC 337 and BC 338

* Preferred device
Dispositif recommandé

The BC 327 and BC 328 transistors are intended for a wide variety of medium power AF amplifier and switching application; they are particularly useful as deflection stage driver, AF output amplifier up to 2 W, driver in Hi Fi amplifier.

They are available as matched pair together with their PNP complementary types BC 337 and BC 338.

Les transistors BC 327 et BC 328 sont destinés aux usages usuels à niveau moyen dans le domaine de l'amplification basse fréquence et de la commutation, notamment : driver d'étage de balayage, driver d'ampli Hi Fi, étage de sortie BF jusqu'à 2 W.

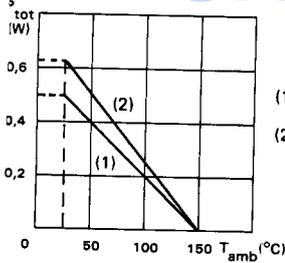
Ils sont complémentaires NPN sous les BC 337 et BC 338 avec lesquels ils peuvent être appariés.

V_{CE0}	$\begin{cases} -45 \text{ V} & \text{BC 327} \\ -25 \text{ V} & \text{BC 328} \end{cases}$
I_{CM}	-1,2 A
$h_{21E}(-100 \text{ mA})$	100 ... 630
f_T	200 MHz

Maximum power dissipation
Dissipation de puissance maximale

Plastic case
Boîtier plastique

F 139 B— See outline drawing CB-76 on last pages
Voir dessin coté CB-76 dernières pages



(1) Without heat sink
Sans radiateur
(2) See note page 3
Voir note page 3



Bottom view
Vue de dessous



Weight : 0,3 g.
Masse

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION

$T_{amb} = +25^\circ\text{C}$

(Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

			BC 327	BC 328	
Collector-emitter voltage Tension collecteur-émetteur		V_{CE0}	-45	-25	V
Collector-emitter voltage Tension collecteur-émetteur		V_{CES}	-50	-30	V
Emitter-base voltage Tension émetteur-base		V_{EBO}	-5	-5	V
Collector current Courant collecteur		I_C	-800	-800	mA
Peak collector current Courant de crête de collecteur		I_{CM}	-1,2	-1,2	A
Base current Courant base		I_B	-100	-100	mA
Power dissipation Dissipation de puissance	See note page 3 Voir note page 3	P_{tot}	500 625*	500 625*	mW
Junction temperature Température de jonction	max	T_j	150	150	$^\circ\text{C}$
Storage temperature Température de stockage	min max	T_{stg}	-65 +150	-65 +150	$^\circ\text{C}$

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES
 $T_{amb} = 25^{\circ}C$ (Unless otherwise stated
(Sauf indications contraires

	Test conditions <i>Conditions de mesure</i>			Min.	Typ.	Max.	
Collector-emitter cut-off current <i>Courant résiduel collecteur-émetteur</i>	$V_{CE} = -45 V$ $I_E = 0$	I_{CES}	BC 327	-2	-100		nA
	$V_{CE} = -25 V$ $I_E = 0$		BC 328	-2	-100		nA
Collector-emitter breakdown voltage <i>Tension de claquage collecteur-émetteur</i>	$I_C = -100 \mu A$ $I_B = 0$	$V_{(BR)CES}$	BC 327	-50			V
			BC 328	-30			V
	$I_C = -10 mA$ $I_B = 0$	$V_{(BR)CEO}$	BC 327	-45			V
			BC 328	-25			V
Collector-emitter saturation voltage <i>Tension de saturation collecteur-émetteur</i>	$I_C = -500 mA$ $I_B = -50 mA$	V_{CEsat}			-0,7		V
Base-emitter voltage <i>Tension base-émetteur</i>	$V_{CE} = -1 V$ $I_C = -300 mA$	V_{BE}			-1,2		V
Static forward current transfer ratio <i>Valeur statique du rapport de transfert direct du courant</i>	$V_{CE} = -1 V$ $I_C = -100 mA$	h_{21E}	cl. 16	100	250		
			cl. 25	160	400		
			cl. 40	250	630		
	$V_{CE} = -1 V$ $I_C = -300 mA$			40			
h_{21E} ratio for a matched pair <i>Rapport de h_{21E} pour une paire</i>	$V_{CE} = 1 V$ $I_C = 100 mA$	$\frac{h_{21E1}}{h_{21E2}}$		0,7	1,25	1,4	

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)
 $T_{amb} = 25^{\circ}C$ (Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

	Test conditions <i>Conditions de mesure</i>			Min. Typ. Max.	
Transition frequency <i>Fréquence de transition</i>	$V_{CE} = -5 V$ $I_C = -10 mA$ $f = 100 MHz$	f_T		200	MHz
Output capacitance <i>Capacité de sortie</i>	$V_{CE} = -10 V$ $I_E = 0$ $f = 1 MHz$	C_{22b}		10	pF

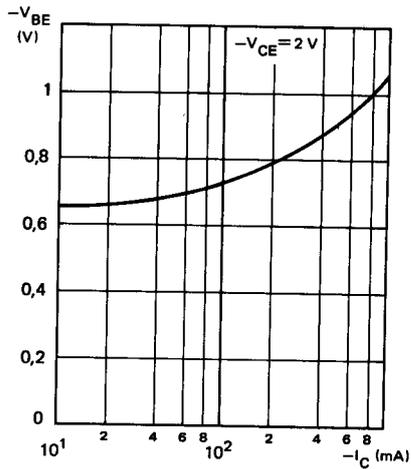
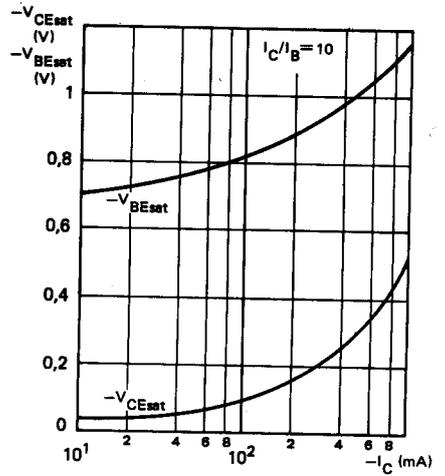
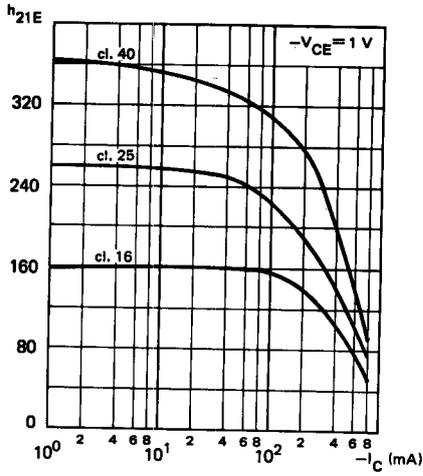
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES

Junction-case thermal resistance <i>Résistance thermique (jonction-boîtier)</i>		$R_{th(j-a)}$		250	$^{\circ}C/W$
Junction-ambient thermal resistance <i>Résistance thermique (jonction-ambiente)</i>		$R_{th(j-a)}$		200*	$^{\circ}C/W$

* When the transistor is mounted on a printed board with 3 mm connection and collector wire connected to a 1 cm² copper area.

Lorsque le transistor est monté sur un circuit imprimé avec une longueur de connexion de 3 mm et une surface cuivrée de 1 cm² réunie à la connexion collecteur.

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES



DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES

